

# Кремниевый фотодетекторный чип 1.42 мм — техническое описание

P/N : WS56-01B

## Применение

Si PIN фотодиодные чипы

## Структура

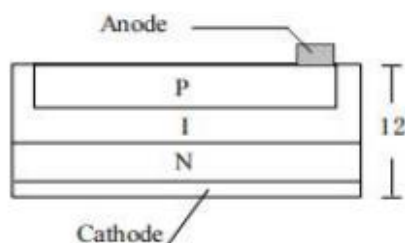
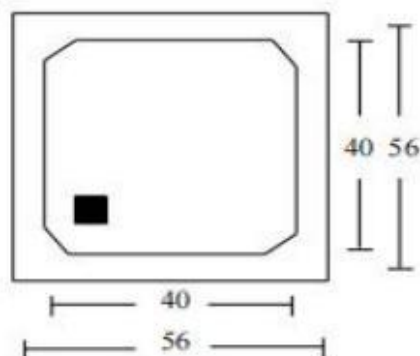
Планарная структура: PIN-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

## ГАБАРИТЫ

| Габариты                   | Мин.              | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|----------------------------|-------------------|------|-------|----------|
| Активная область           | 40 × 40           |      |       | мил      |
| Ширина чипа                | 56 × 56 ( ± 1.0 ) |      |       | мил      |
| Длина чипа                 | 56 × 56 ( ± 1.0 ) |      |       | мил      |
| Высота чипа                | 12 ( ± 1.0 )      |      |       | мил      |
| Контактная площадка катода | 6.4 × 6.4         |      |       | мил      |
| Контактная площадка анода  | 6.4 × 6.4         |      |       | мил      |

## Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

| Параметр                   | Обозначение | Условия измерения | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|----------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|----------|
| Прямое напряжение          | VF          | IF=10mA, H=0      | 0.5  |      | 1.3   | В        |
| Обратное напряжение        | VBR         | IR=100μA, H=0     | 35   |      |       | В        |
| Обратный темновой ток      | ID          | VR=10V, H=0       |      |      | 10    | нА       |
| Рабочий диапазон длин волн | λp          |                   |      | 940  |       | нм       |
| Емкость                    | CJ          | VR=3V, F=1 MHz    |      | 11   |       | пФ       |



Ед.: мил